

■ 公募情報

|  |   |
|--|---|
| 公募No.                                    | 2025T-22  |
| 職種                                       | 有期研究技術員   |
| 部署                                       | 未来 I C T 研究所 小金井フロンティア研究センター超高周波 I C T 研究室  |
| 業務名                                      | テラヘルツ波電力増幅デバイス・集積回路の開発  |
| 業務内容                                     | テラヘルツ帯の無線通信及びセンシングのため、InGaAs系・InP系・GaN系などの化物半導体を用いた電力増幅デバイス・MMIC集積回路の開発を行うとともに、電力増幅デバイス及びMMIC集積回路の性能評価及び高周波計測を行う。また、開発および評価計測に使用する機器の維持管理、更には当機構職員等への機器操作支援および技術指導・相談を行う。   |
| 自発的な研究活動等の実施に関して                         | 機構内外の競争性を有する研究資金（科研費等）への申請資格がありません。   |
| 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第15条の2の対象業務該当の有無 | 【有】   |
| 応募要件                                     | 電力増幅デバイスやMMIC集積回路、化合物半導体デバイスやSi-CMOS、能動・受動素子、これらデバイス等の性能評価や高周波計測に関する知識と経験を有すること。なお、電力増幅デバイスやMMIC集積回路の開発において、半導体製造装置を使用した開発経験やファウンドリーサービスやプロセスデザインキット（PDK）を使用した開発経験があれば望ましい。 |
| 募集人員                                     | 1 人   |
| 本年度契約期間                                  | 採用日 ～ 令和8年3月31日（更新の可能性：有り）  |
| 更新した場合の雇用期間（又は期日）                        | 一定の条件を満たした場合に、採用日より最長5年   |
| 給与（基本給）                                  | 419,000円 ～ 611,000円／月<br>本給は学歴や職務経験等を考慮し決定します。ただし、本給については、国家公務員の給与に準拠していることから国家公務員の給与に改正があり、当機構労働組合等の合意後に本給の改定が生じた場合は変更する。  |
| 勤務地名称                                    | 本部<br>（東京都小金井市）   |
| 勤務頻度                                     | 週5日（週37時間30分勤務） ※時間外労働有   |

※ 部署名および勤務地名称（業務名、業務内容の記載を含む）に関しては、組織改編等により変更となる場合があります。

※ 従事する業務及び勤務地の変更範囲：原則として変更無し